

Содержание

● XXVII Международный симпозиум „Нанопериферия и нанопериферия“, Н. Новгород, 13–16 марта 2023 г.

Шамирзаев Т.С.

Формирование заряженных вакансий в анионной подрешетке AlAs 225

Артёмов Е.А., Мантузов А.В., Журкин В.С., Божко А.Д., Кудрявцев О.С., Андрюшечкин Б.В., Шевлюга В.М., Шицевалова Н.Ю., Филипов В.Б., Глушков В.В.

Особенности структуры поверхности и поверхностного электронного транспорта в коррелированном топологическом изоляторе SmB₆ 232

Алешкин В.Я., Рудаков А.О., Дубинов А.А.

Оптимизация параметров гетероструктуры CdHgTe/HgTe с одиночной квантовой ямой для генерации плазмон-фононов 237

Ермина А.А., Солодовченко Н.С., Пригода К.В., Левицкий В.С., Павлов С.И., Жарова Ю.А.

ГКР-активные подложки на основе внедренных наночастиц Ag в объем c-Si: моделирование, технология, применение 243

Яблонский А.Н., Юрасов Д.В., Захаров В.Е., Перетокин А.В., Степихова М.В., Шалеев М.В., Шенгуров Д.В., Родякина Е.Е., Смагина Ж.В., Дьяков С.А., Новиков А.В.

Влияние условий оптического возбуждения на спектральные и временные характеристики излучения двумерных фотонных кристаллов с Ge(Si)-наноостровками 251

Кукушкин В.А., Лобаев М.А., Вихарев А.Л., Горбачев А.М., Радищев Д.Б., Архипова Е.А., Дроздов М.Н., Кукушкин Ю.В., Исаев В.А., Богданов С.А.

Переход между законами Мотта и Аррениуса в температурных зависимостях сопротивлений сильно легированных бором дельта-слоев в искусственном алмазе 259

Литвяк В.М., Чербунин Р.В., Солдатенков Ф.Ю., Калевич В.К., Кавокин К.В.

Проявление диполь-дипольного и квадрупольного взаимодействий в спектре коррелятора оптически охлажденных ядерных спинов объемного кристалла n-GaAs 265

Забавичев И.Ю., Пузанов А.С., Оболенский С.В.

Влияние процесса образования единичного кластера радиационных дефектов на переключение состояния транзисторной ячейки памяти 270

Балакирев С.В., Кириченко Д.В., Комаров С.Д., Драгунова А.С., Черненко Н.Е., Шандыба Н.А., Крыжановская Н.В., Жуков А.Е., Солодовник М.С.

Влияние давления мышьяка при заращивании квантовых точек InAs тонким низкотемпературным слоем GaAs на их оптические свойства 276

Кумар Рави, Теленков М.П., Митягин Ю.А.

Энергетическая структура мультиэкситонов в квантовых проволоках с продольным ограничивающим потенциалом 282

● Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Соболев Н.А., Калядин А.Е., Штельмах К.Ф., Аруев П.Н., Забродский В.В., Шек Е.И.

Температурная зависимость дислокационной электролюминесценции в кремниевых светодиодах с кислородными преципитатами 289

● Физика полупроводниковых приборов

Слипченко С.О., Соболева О.С., Подоскин А.А., Кириченко Ю.К., Багаев Т.А., Яроцкая И.В., Пихтин Н.А.

Исследование динамики включения низковольтных InP-гомотристоров 295

Максимов М.В., Шерняков Ю.М., Корнышов Г.О., Симчук О.И., Гордеев Н.Ю., Бекман А.А., Паюсов А.С., Минтаиров С.А., Калужный Н.А., Кулагина М.М., Жуков А.Е.

Широкополосное излучение суперлюминесцентных диодов на основе многослойных структур с квантовыми ямочками InGaAs/GaAs 301